

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია:

1. J. Markhulia, O. Kvitsiani, R. Mirianashvili. ESR Investigation of Condition of Cu<sup>2+</sup> Ions in Natural Zeolite of Georgia – Clinoptilolite. PIC (Proceedings of the Institute of Cybernetics). VOL.3, N1-2, 241-245 (2004).
2. T. Laperashvili, V. Mikelashvili, O. Kvitsiani, D. Lapherashvili, Electrical Characteristics of Fe/GaAs Structures. Georgian Engineering News, 4, 23-26 (2008).
3. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ჯ. მარხულია, გ. ნაკაშიძე, თ. ნაკაიძე. კომპენსირებული გალიუმის ფოსფიდის ბაზაზე შექმნილი დიოდის ელექტრული და ფოტოელექტრული მახასიათებელი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი - კერამიკა. 1-2(20-21), 204-208 (2009).
4. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ჯ. მარხულია, თ. გულიაშვილი, დ. ლაფერაშვილი. ომური კონტაქტები – III-V ჯგუფის ნახევარგამტარებზე, მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 10-12, 9-15 (2010).
5. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ვ. მიქელაშვილი, ჯ. მარხულია, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები, 193-198, ISBN: 978-9941-416-34-7 (2010).
6. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, I. Imerlishvili, D. Lapherashvili, Terahertz pulse detection by the GaAs Schottky diodes, Proceedings of SPIE, Nonlinear Optics and Applications IV. 7728 (2010).
7. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Lapherashvili, I. Imerlishvili, Ferromagnetic Metal/GaAs Heterostructure. New Development in Material Science (eBook). NOVA Publisher, Chapter 12, ISBN: 978-1-61668-907-0 (2010).
8. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Lapherashvili, I. Imerlishvili, Optical Switching Mechanism in Double in Double Injection GaP Devices. Georgian Engineering News. 2, 94-100 (2011).
9. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Lapherashvili, I. Imerlishvili, The Method of Fabrication and the Properties of GaAs Shottky Diodes. Georgian Engineering News. 2, 101-108 (2011).
10. ო. კვიციანი, ჰეტეროსტრუქტურული მზის ელემენტები, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 32-41 (2011).
11. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. გალიუმის არსენიდზე შოტკის ბარიერის წარმოქმნის მექანიზმები. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 109-120 (2011).
12. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ი. ლლონტი, თ. გულიაშვილი, ვ. მიქელაშვილი. გალიუმის არსენიდზე მცირე წინაღობიანი ომური კონტაქტების მიღება და კვლევა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 121-130 (2011).
13. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, დ. ლაფერაშვილი, ი. ლლონტი. თერმოდამუშავების გავლენა ნახევარგამტარისა და ლითონის კონტაქტის ფოტოელექტრულ მახასიათებელზე, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 131-140 (2011).
14. თ. ლაფერაშვილი, დ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. ტერაჰერცული სიხშირის გამომსხივებლები და ფოტონური მიმღებები III-V ჯგუფის ნახევარგამტარების კვანტურწერტილოვანი სტრუქტურების ბაზაზე, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის

- მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 141-151 (2011).
15. თ. კვიციანი, თ. ლაფერაშვილი, დ. ლაფერაშვილი, ი. იმერლიშვილი. კომპენსირებული ნახევარგამტარის ფოტოგამტარობა, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 152-165 (2011).
  16. თ. ლაფერაშვილი, თ. კვიციანი. ომური კონტაქტი III-V ჯგუფის ნახევარგამტარებზე, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 166-193 (2011).
  17. თ. ლაფერაშვილი, თ. კვიციანი. შოტკის ბარიერის ფორმირების მექანიზმები III-V ნახევარგამტარებზე და დიოდების ფიზიკური მახასიათებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 7-9, 8-16 (2011).
  18. თ. ლაფერაშვილი, თ. კვიციანი, III-V ნახევარგამტარული კვანტურწერტილოვანი სტრუქტურები მესამე თაობის მზის ელემენტებში, 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, კონფერენციის შრომების კრებული, 2, 229-235 (2012).
  19. თ. ლაფერაშვილი, თ. კვიციანი, მ. ელიზბარაშვილი, დ. ლაფერაშვილი. ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და UV ნახევარგამტარიანი დოზიმეტრი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 3(717), 76-80 (2014).
  20. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, M. Elizbarashvili. Nanostructured III-V Semiconductor solar cells. Georgian Engineering News, 4, 29-34 (2014).
  21. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, M. Elizbarashvili, A. Chanishvili, D. Laperashvili. Nanotechnology and semiconductor devices. Nano Studies, 10, 83-88 (2014).
  22. V. Mikelashvili, T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Laperashvili. Solar cells based on InP/GaP/Si structure. Proceedings of SPIE, Optoelectronic Devices and Integration VI, 100191G, 10019 (2016).
  23. T. Laperashvili, O. Kvitsiani. III-V Semiconductor Nanostructure for Solar Cells, Nano Studies, 14, 239-244 (2016).
  24. T.A. Laperashvili, O.R. Kvitsiani and D.L. Laperashvili, Fabrication of InP nanostructured layer on GaP surface, Georgian Engineering News, 85, 1, 34-38 (2018).
  25. თინათინ ლაფერაშვილი, ორესტ კვიციანი, ფოტოვოლტური მზის ელემენტების ეფექტიანობის გაზრდის გზები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2, 33-45 (2018).